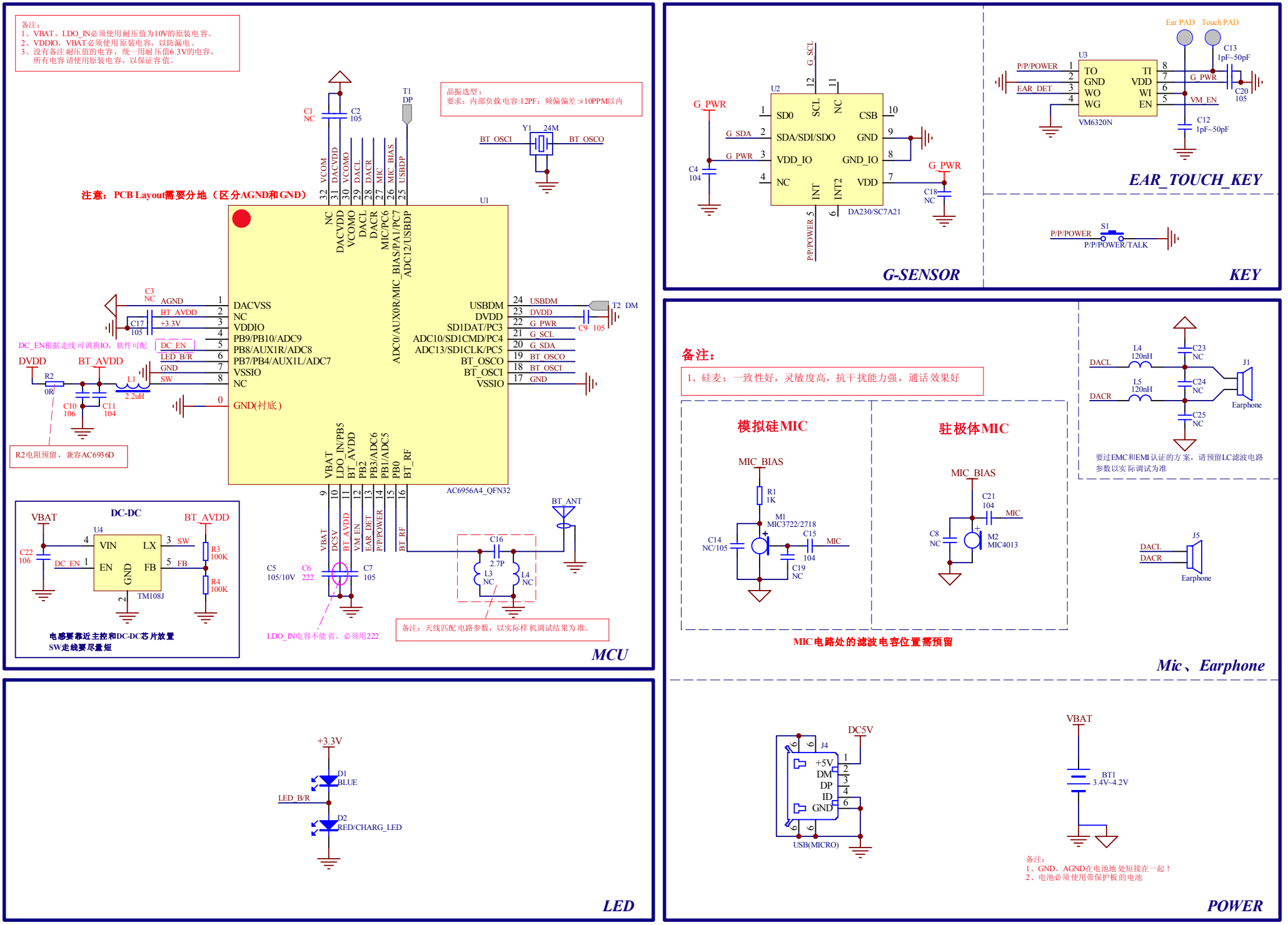

备注：
1、VBAT，LDO_IN必须使用耐压值为10V的原装电容。
2、VDDIO，VBAT必须使用原装电容，以防漏电。
3、没有备注耐压值的电容，统一用耐压值6.3V的电容，
所有电容请使用原装电容，以保证容值。
晶振选型：
要求：内部负载电容:12PF；频偏偏差±10PPM以内
注意：PCB Layout需要分地（区分AGND和GND）
U1
AC6956A4_QFN32
DACVSS
NC
VDDIO
PB9/PB10/ADC9
PB8/AUX1R/ADC8
PB7/PB4/AUX1L/ADC7
VSSIO
NC
GND(衬底)
USBDM
DVDD
SD1DAT/PC3
ADC10/SD1CMD/PC4
ADC13/SD1CLK/PC5
BT_OSCO
BT_OSCI
VSSIO
ADC0/AUX0R/MIC_BIAS/PA1/PC7
ADC12/USBDP
NC
DACVDD
VCOMO
DACL
DACR
MIC/PC6
VBAT
LDO_IN/PB5
BT_AVDD
PB2
PB3/ADC6
PB1/ADC5
PB0
BT_RF
DC_EN根据走线 可调换IO，软件可配
R2电阻预留，兼容AC6936D
LDO_IN电容不能省，必须用222
备注：天线匹配 电路参数，以实际样 机调试结果为准。
DC-DC
U4
VIN
LX
EN
GND
FB
TM108J
电感要靠近主控和DC-DC芯片放置
SW走线要尽量短
MCU
G-SENSOR
U2
DA230/SC7A21
SD0
SDA/SDI/SDO
VDD_IO
NC
SCL
NC
CSB
GND
GND_IO
INT
INT2
VDD
P/P/POWER
G_PWR
G_SDA
G_SCL
EAR_TOUCH_KEY
U3
VM6320N
TO
GND
WO
WG
TI
VDD
WI
EN
Ear PAD
Touch PAD
P/P/POWER
EAR_DET
G_PWR
VM_EN
KEY
P/P/POWER/TALK
备注：
1、硅麦：一致性好，灵敏度高，抗干扰能力强，通话效果好
模拟硅MIC
MIC_BIAS
M1
MIC3722/2718
驻极体MIC
M2
MIC4013
MIC电路处的滤波电容位置需预留
Earphone
要过EMC和EMI认证的方案，请预留LC滤波电路
参数以实际调试为准
Mic、Earphone
+3.3V
D1
BLUE
D2
RED/CHARG_LED
LED_B/R
LED
DC5V
J4
+5V
DM
DP
ID
GND
USB(MICRO)
VBAT
BT1
3.4V~4.2V
备注：
1、GND、AGND在电池地 处短接在一起！
2、电池必须 使用带保护板的电池
POWER